

Содержание

- **Неэлектронные свойства полупроводников (атомная структура, диффузия)**

Иванов А.М., Козловский В.В., Строкан Н.Б., Лебедев А.А.

Распределение по энергии атомов отдачи и формирование радиационных дефектов в пленках карбида кремния при протонном облучении 145

Ахмедова Г.А., Абдинова Г.Дж., Абдинов Д.Ш.

Влияние отжига на электрические свойства монокристаллов РbТе, легированных таллием 149

- **Электронные свойства полупроводников**

Таиров Б.А., Ибрагимова О.И., Рагимов А.Г., Бразис Р.

Проявление легких и тяжелых электронов в гальваномагнитных характеристиках монокристаллов $n\text{-Bi}_{0.88}\text{Sb}_{0.12}$, легированных Те 152

Бут А.В., Мигаль В.П., Фомин А.С.

Асимметрия фотоотклика кристаллов CdZnTe 157

Велиев Р.Г.

О магнитном фазовом переходе в сильноцепочечных полупроводниковых соединениях TlFeS_2 , TlFeSe_2 162

- **Спектроскопия, взаимодействие с излучениями**

Новиков Г.Ф., Рабенко Е.В., Бочаров К.В., Личкова Н.В., Овчинников О.В., Латышев А.Н.

Фотоэлектрические и люминесцентные свойства хлорида серебра, легированного диспрозием 166

- **Поверхность, границы раздела, тонкие пленки**

Комолов А.С., Лазнева Э.Ф., Комолов С.А., Бузин И.С., Зимина М.В.

Фотовольтаические свойства интерфейсов органической пленки замещенного перилена с поверхностью TiO_2 и SnO_2 173

Гулямов Г., Шарибаев Н.Ю.

Определение плотности поверхностных состояний границы раздела полупроводник-диэлектрик в МДП структуре . . 178

- **Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления**

Абрамкин Д.С., Журавлёв К.С., Шамирзаев Т.С., Ненашев А.В., Калагин А.К.

Захват носителей заряда в InAs/AlAs-квантовые точки при гелиевой температуре 183

● **Физика полупроводниковых приборов**

Савельев А.В., Максимов М.В., Жуков А.Е.

Ширина спектра лазерной генерации в лазерах на квантовых точках: аналитический подход 245

Михайлова М.П., Андреев И.А., Моисеев К.Д., Иванов Э.В., Коновалов Г.Г., Михайлов М.Ю., Яковлев Ю.П.

Фотовольтаический детектор на основе гетероструктуры II типа с глубокой квантовой ямой AlSb/InAsSb/AlSb в активной области для среднего инфракрасного диапазона . 251

Беляев А.Е., Басанец В.В., Болтовец Н.С., Зоренко А.В., Капитанчук Л.М., Кладько В.П., Конакова Р.В., Колесник Н.В., Коростинская Т.В., Крицкая Т.В., Кудрик Я.Я., Кучук А.В., Миленин В.В., Атаубаева А.Б.

Влияние перегрева p – n -перехода на деградацию мощных импульсных кремниевых лавинно-пролетных диодов . . . 256

● **Изготовление, обработка, тестирование материалов и структур**

Попова Т.Б., Бакалейников Л.А., Флегонтова Е.Ю., Шахмин А.А., Заморянская М.В.

Рентгеноспектральный микроанализ гетероструктур с наноразмерными слоями 263

Володин В.А., Качко А.С.

Кристаллизация пленок аморфного гидрогенизированного кремния с применением фемтосекундных лазерных импульсов 268

Цацульников А.Ф., Лундин В.В., Заварин Е.Е., Николаев А.Е., Сахаров А.В., Сизов В.С., Усов С.О., Мусихин Ю.Г., Gerthsen D.

Влияние водорода на локальную фазовую сепарацию в тонких слоях InGaN и свойства светодиодных структур на их основе 274

● **Персоналии**

Фирудин Мамед Али оглы Гашимзаде

(к 75-летию со дня рождения) 280